

关键指标

射频&本振频率：8~12GHz
中频频率：DC~4GHz
本振功率：13dBm
变频损耗：6.5dB
LO/RF 隔离度：35dB
芯片尺寸：1.1mm×0.75mm×0.1mm

产品简介

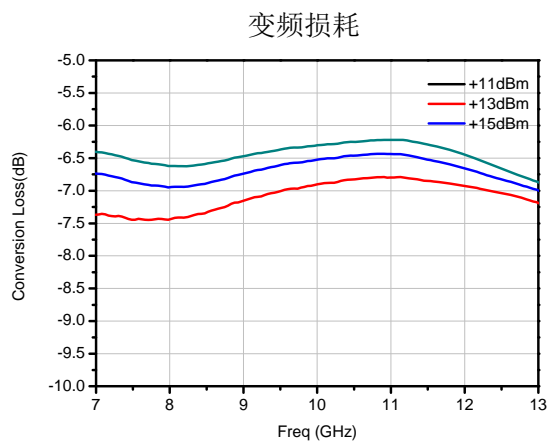
HG125H-1 是一款无源双平衡混频器芯片，射频和本振频率为8~12GHz，中频频率为DC~4GHz，变频损耗为6.5dB。

电性能 (T_A=25℃)

指标	最小值	典型值	最大值
RF&LO 频率(GHz)	8~12		
IF 频率(GHz)	DC~4		
变频损耗(dB)	—	6.5	—
LO~RF 隔离度(dB)	—	35	—
LO~IF 隔离度(dB)	—	30	—
RF~IF 隔离度(dB)	—	15	—

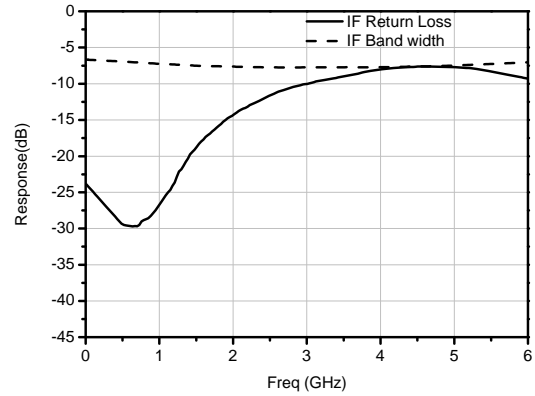
典型测试曲线

未注明情况下 IF=100MHz

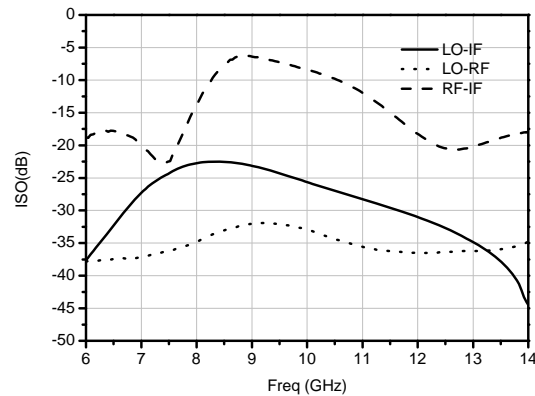


中频带宽

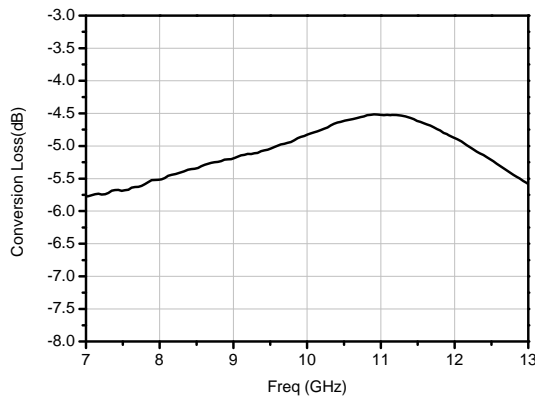
IF : 0.01-6GHz
RF: 7GHz
LO: 7.01-13GHz



隔离度



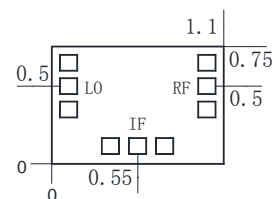
上变频损耗



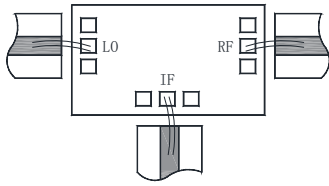
绝对额定最大值

最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。